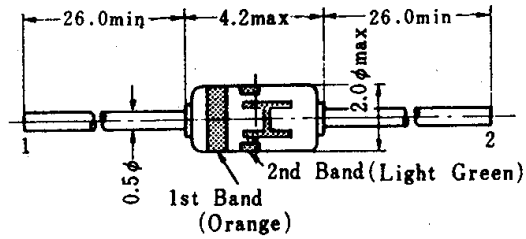


1S2348(H)

シリコンエピタキシャルプレーナ形
高速度スイッチング用

SILICON EPITAXIAL PLANAR
HIGH SPEED SWITCHING



1. カソード : Cathode
 2. アノード : Anode
- (Dimensions in mm)

(JEDEC DO-35)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	1S2348(H)	Unit
逆 電 圧	V_R	65	V
平 均 整 流 電 流	I_O	250	mA
せ ん 頭 順 電 流	$i_F(\text{peak})$	750	mA
サ ー ジ 順 電 流	$I_F(\text{surge})$	4	A
接 合 部 温 度	T_j	175	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-65~+175	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
順 電 圧	V_F	$I_F=100\text{mA}$	—	0.8	1.0	V
逆 破 壊 電 圧	$V_{(BR)R}$	$I_R=1\mu\text{A}$	65	—	—	V
逆 電 流	I_R	$V_R=55\text{V}$	—	—	1.0	μA
端 子 間 容 量	C	$V_R=0, f=1\text{MHz}$	—	—	4	pF
逆 回 復 時 間	t_{rr}	$I_F=I_R=500\text{mA}$ See Test Circuit	—	—	8.0	ns

t_{rr} 測定回路
 t_{rr} TEST CIRCUIT

